

120V SGT工艺N-Channel MOSFET

产品介绍

- 1.采用扬杰科技SGT特殊工艺制程，根据电机驱动和电源应用要求，优化导通内阻（Rdson）和栅极电荷（Qg）性能，降低导通损耗和开关损耗，提升系统效率；
- 2.解决高速Gan电源应用时di/dt大带来的副边电压尖峰高的问题，提升产品整体的可靠性。

产品特点

- 1.采用扬杰科技SGT特殊工艺制程设计，具有更高的工艺稳定性和可靠性；
- 2.系列产品具有更快的开关速度，更小的栅电荷和更高的应用效率；
- 3.采用PDFN5060封装，更好的热阻特性。

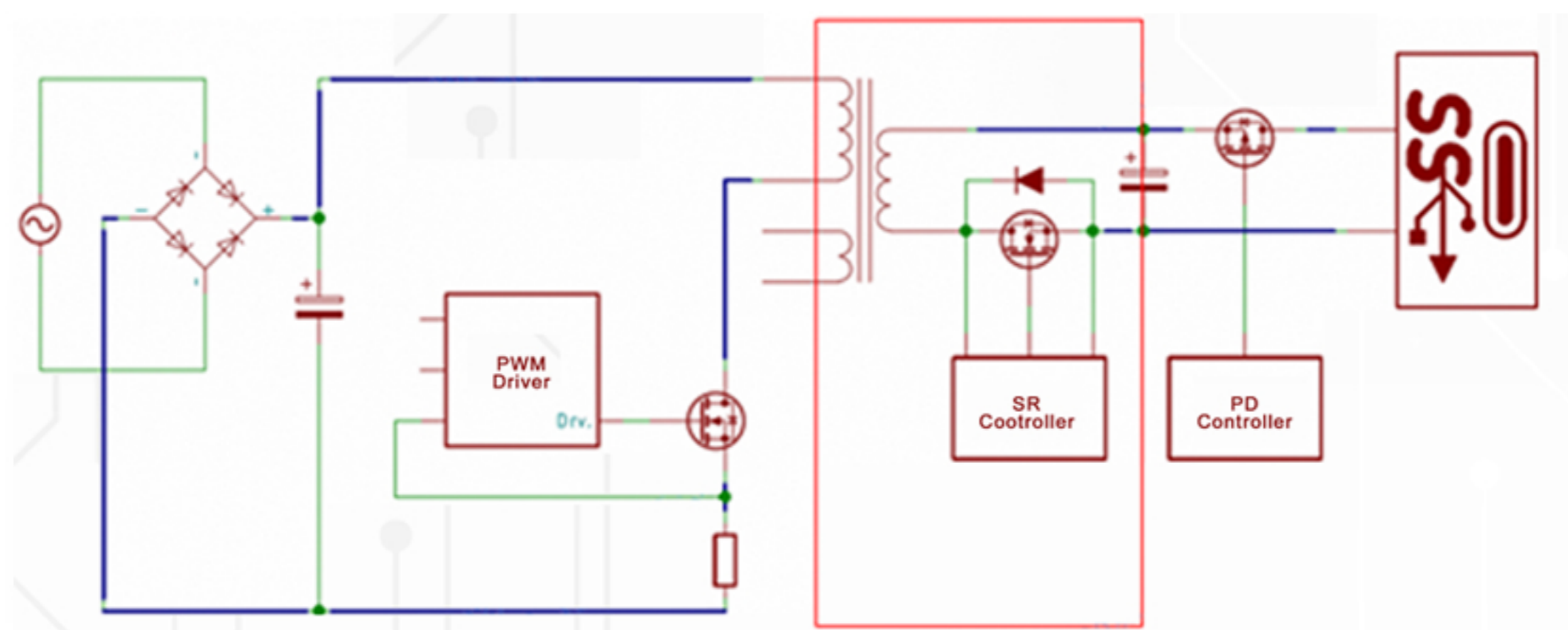
电性参数

PART NO	Package	V _{DSS} (V)	I _D (A)	V _{GS} (V)	V _{th} (V)			R _{dson} (mΩ) @V _{GS} 10V		R _{dson} (mΩ) @V _{GS} 4.5V		C _{iss} (pF)	C _{oss} (pF)	C _{rss} (pF)	Q _g (nC)
					Min	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Typ	Typ	Typ
YJG88G12A	PDFN5060	120	88	±20	1	2	3	6.4	7.6	7.6	9.6	4619	924	28	72

更多产品详见官网

应用电路

同步整流应用电路



应用领域

电源

电机

